

半 导 体 学 报

第 10 卷 第 9 期 1989 年 9 月

目 录

- Si(113) 表面电子结构的研究
.....张瑞勤 王家俭 戴国才 吴汲安 张敬平 邢益荣 (645)
- Ce 在 Si(111) 面上吸附的 EHT 研究方法王 磊 叶 令 (653)
- Ni/Si, Pt/Si, Ir/Si 系的 As 离子注入和退火
.....吴春武 殷士端 张敬平 范熨文 刘家瑞 朱沛然 (659)
- 用离子束混合及快速热处理方法形成钽的硅化物姚文卿 Heiner Ryssel (667)
- 中子辐照损伤区对硅少数载流子寿命的影响
.....施 毅 吴凤美 沈德勋 程开甲 王长河 (672)
- 一种可编程逻辑阵列的布局算法薄建国 (680)
- 用于半导体器件瞬态特性研究的大幅度矩形纳秒脉冲发生器
.....周 旋 鲍秉乾 李 强 李锦林 (688)
- 择优生长的多晶硅压阻统计理论赵甘鸣 鲍敏杭 (693)
- 研究 简 报**
- 非晶硅中的硅氢键与光致亚稳缺陷秦国刚 孔光临 (702)
- 氨气敏 Pd-Ir 合金栅 MOS 晶体管张维新 赵玲娟 (706)
- 等离子刻蚀铬膜的研究杨民杰 张骥华 孙 蓉 卢平芳 陈志强 (709)
- 1.55 μm GaInAsP/InP DFB-DC-PBH 激光器
.....赵嵩山 马 馨 周 宁 杨新敏 董志江 (712)
- GaP:N, Zn 中等电子陷阱与 Zn 受主之间的辐射复合
.....余 琦 张 勇 郑健生 颜炳章 (717)
- 氢在金刚石表面的吸附徐丹东 叶 令 (722)